

Investor Relations | 2018년 8월



## 유의사항

본 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 2분기 재무 실적 추정치를 기준으로 작성되었습니다.

외부감사인의 회계검토가 완료되었으나, 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 기말 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

본 자료에 포함된 예측정보는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인해 실제 미래 실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다.

# 회사 현황

회사명	(주)원익머트리얼즈
대표이사	한 우 성
설립일	2006년 12월 04일
발행주식수	6,304,000 (2018.07.31 기준)
자본금	31.5억원 (2018.07.31 기준)
임직원수	339명 (2018.07.31 기준)
주요사업	고순도 특수가스 제조업
본사 및 양청사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 - 대지 50,845㎡ / 건물 5,636㎡
양청2사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 26 - 대지 68,970㎡
오창사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 - 대지 20,837㎡/건물 6,760㎡
전의사업장	세종특별자치시 전의면 산단길 21-125 - 대지 42,160㎡ /건물 6,714㎡
홈페이지	<a href="http://www.wimco.co.kr">www.wimco.co.kr</a>

본사 및 양청사업장



오창사업장



전의사업장



판교영업소



# 연결대상 종속회사 ('18. 2Q 기준 5개사)

# 주주구성

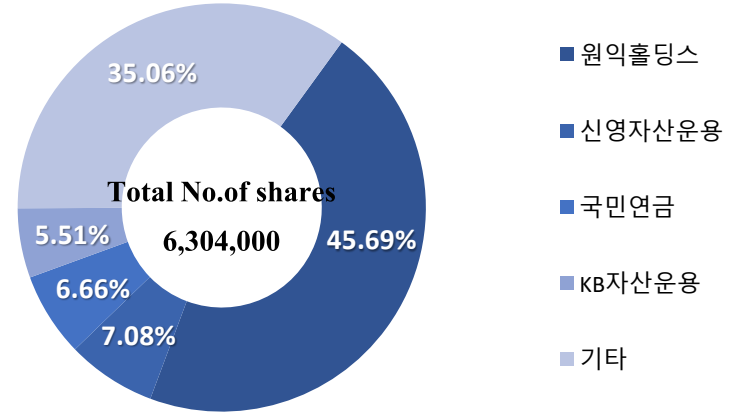


## America

WMNA(구.Nova-kem) 지분 100%

## China

- 원익(서안)반도체과기유한공사 지분 54.49%
- 서안신원익반도체재료유한공사 지분 100%
- 위남원익반도체재료유한공사 지분 100%
- 함양원익반도체무역유한공사 지분 100%



Shareholder	No.	Ownership	Remarks
원익홀딩스	2,880,000	45.69%	Major Shareholder
국민연금	419,868	6.66%	
신영자산운용	418,113	6.63%	
KB자산운용	347,233	5.51%	
Others	2,238,786	35.51%	
합 계	6,304,000	100.00%	

- 18년06월30일 기준 임원,주요주주특정 증권 등 소유상황 보고서 및 주식등의 대량보유상황보고서를 참조하여 작성하였으므로 주주들의 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있음

## 중국 생산공장 현지화를 통한 SEC 서안 공급 안정화 및 중국 Local 진출로 고객 다변화 노력

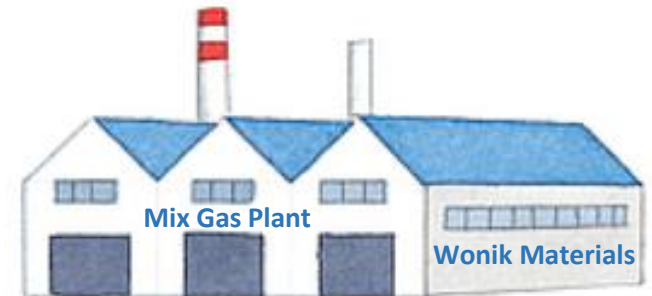


### 서안신원익반도체재료유한공사(서안)

- 설립일 : '18. 01. 18
- 면적 : 22,149m<sup>2</sup>
- 주요기능
  - i. Gas저장창고
  - ii. 분석센터
  - iii. 정제/소분 시설

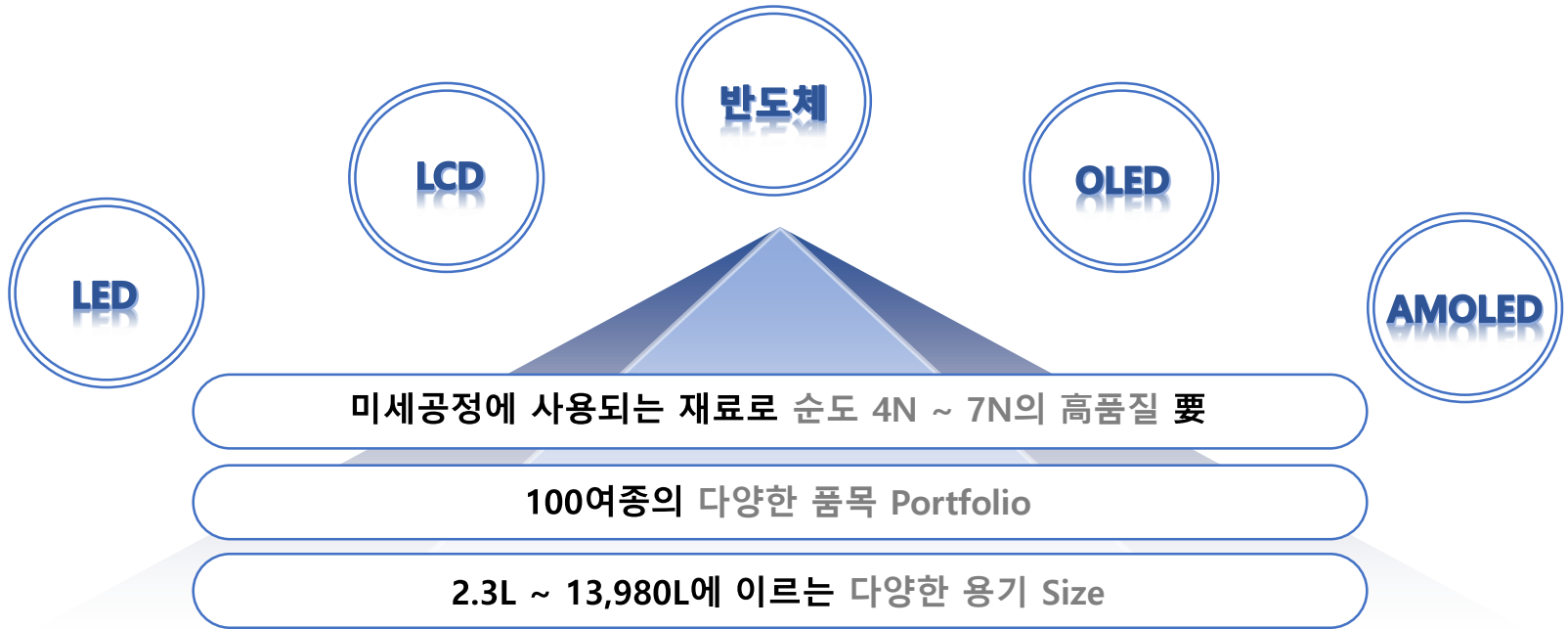
### 위남원익반도체재료유한공사(푸청)

- 설립일 : '18. 04. 12
- 면적 : 59,400m<sup>2</sup>
- 주요기능
  - i. N2O 합성/정제 시설
  - ii. Mix Gas Room

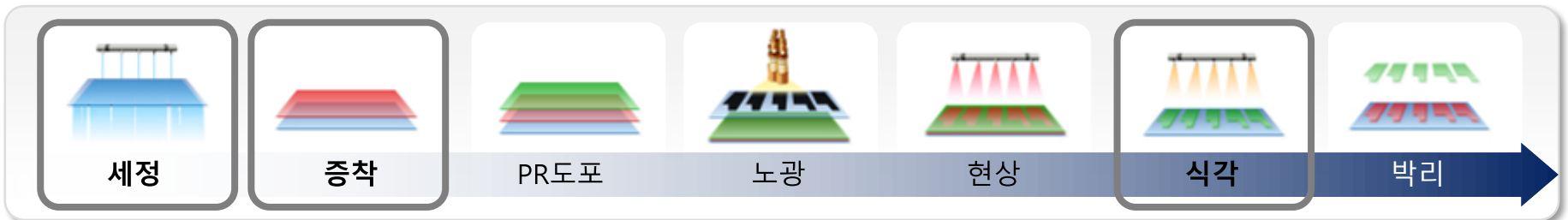


# 사업영역

新공정 개발 시 필수 고려되며, 공정 수율과 직결되는 핵심 재료  
반도체, LCD, OLED 등 다양한 분야 적용



## 반도체 및 디스플레이 공정의 특수가스 주요영역



## 제품

## 상품

### 세정

#### F2 MIX

· Device 미세화에 따라 Dry Cleaning 공정 채택을 증가

#### CO2(저순도)

· Device 미세화에 따른 공정개선 목적으로 Wafer Cleaning에 사용되며, Photo Immersion공정에도 사용

### 증착

#### N2O

· 반도체, LCD 공정에서 SiH4와 결합하여 SiO2의 산화막을 증착시키는데 사용

#### Si2H6

· Device의 미세화로 인해 기존 SiH4로 구현 불가능한 공정에 실리콘 증착으로 사용되는 소재로 SiH4대비 탁월한 성능의 가스

#### NH3

· 반도체, LCD 공정에서 SiH4와 결합하여 Si3N4 절연막을 증착시 사용. LED 공정에서는 TMGa와 결합

#### GeH4 MIX

· SiH4와 결합하여 SiGe 형태로 증착되는 가스

### 식각

#### C4F8

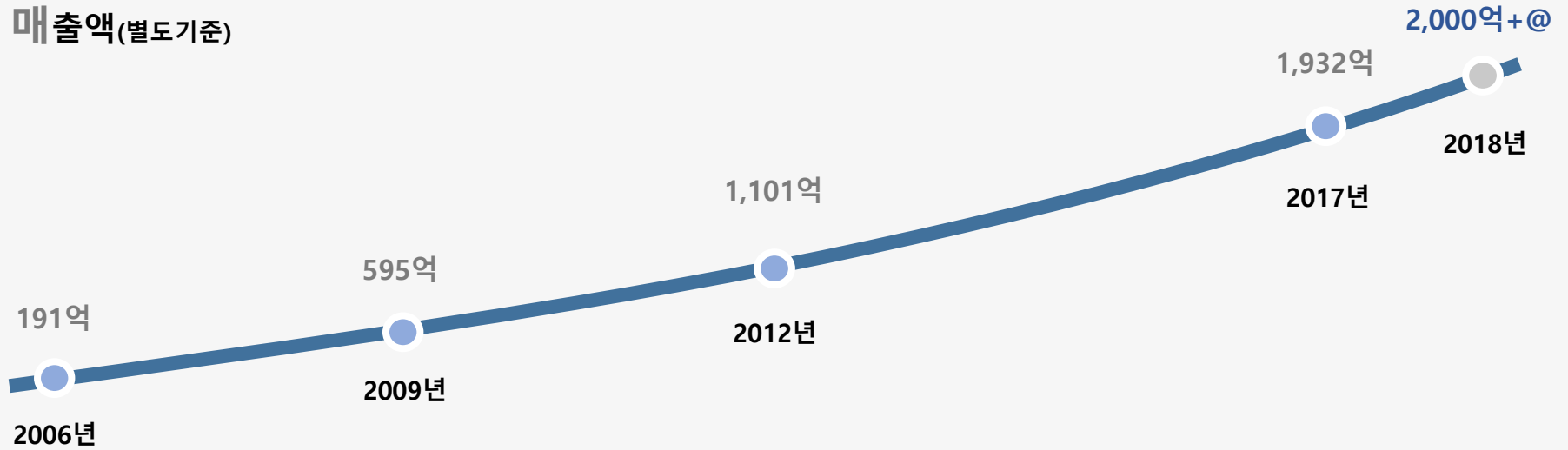
· 산화막 식각공정에 사용되는 가스

#### CH2F2

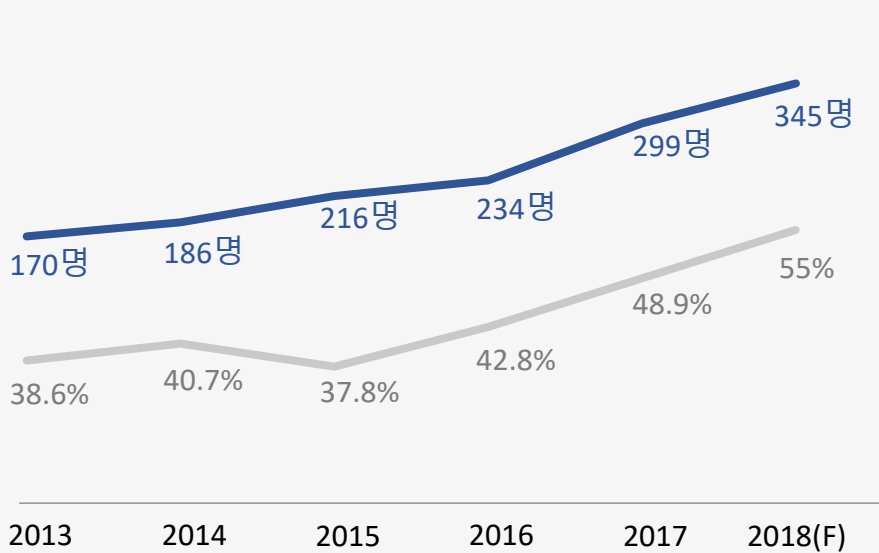
· 질화막 식각공정에 사용되는 가스

# 성장과정

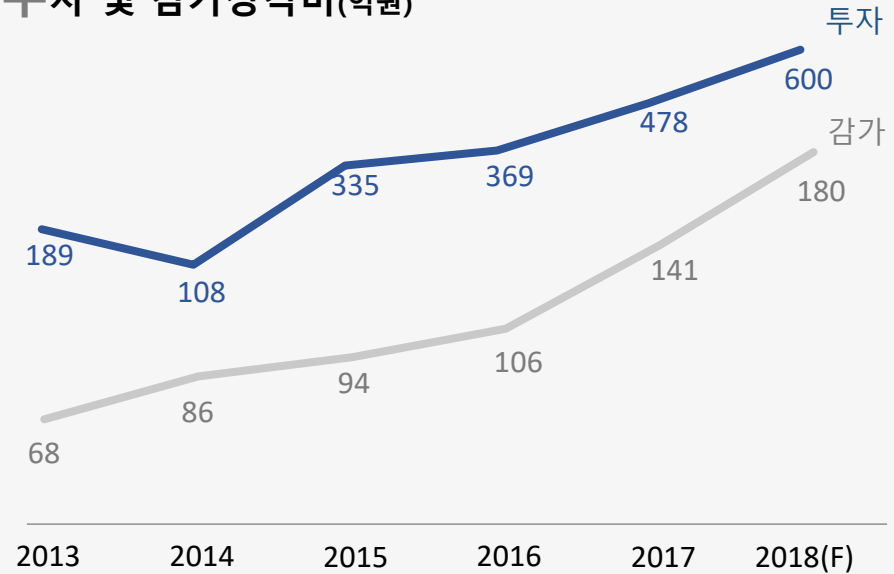
## 매출액(별도기준)



## 제품비중(%) 및 인원(명)



## 투자 및 감가상각비(억원)





## 국내외 고객사 Demand에 대응하기 위한 N2O 공장 3,600Ton 규모 증설



## 2분기 실적

### 2018년 2분기 경영 실적 (연결기준)

(단위: 백만원, %)

2018년 1H							
구분	2018.2Q	2018.1Q	QOQ	QOQ (%)	2017.2Q	YOY	YOY (%)
매출액 (Sales)	54,394	48,889	+5,505	+11.3%	49,431	+4,963	+10.0%
영업이익 (O.P)	11,534	6,664	+4,870	+73.1%	8,113	+3,421	+42.2%
(%)	21.2%	13.6%	-	-	16.4%	-	-

\* K-IFRS 적용 기준

### 2018년 2분기 경영 실적 (별도기준)

(단위: 백만원, %)

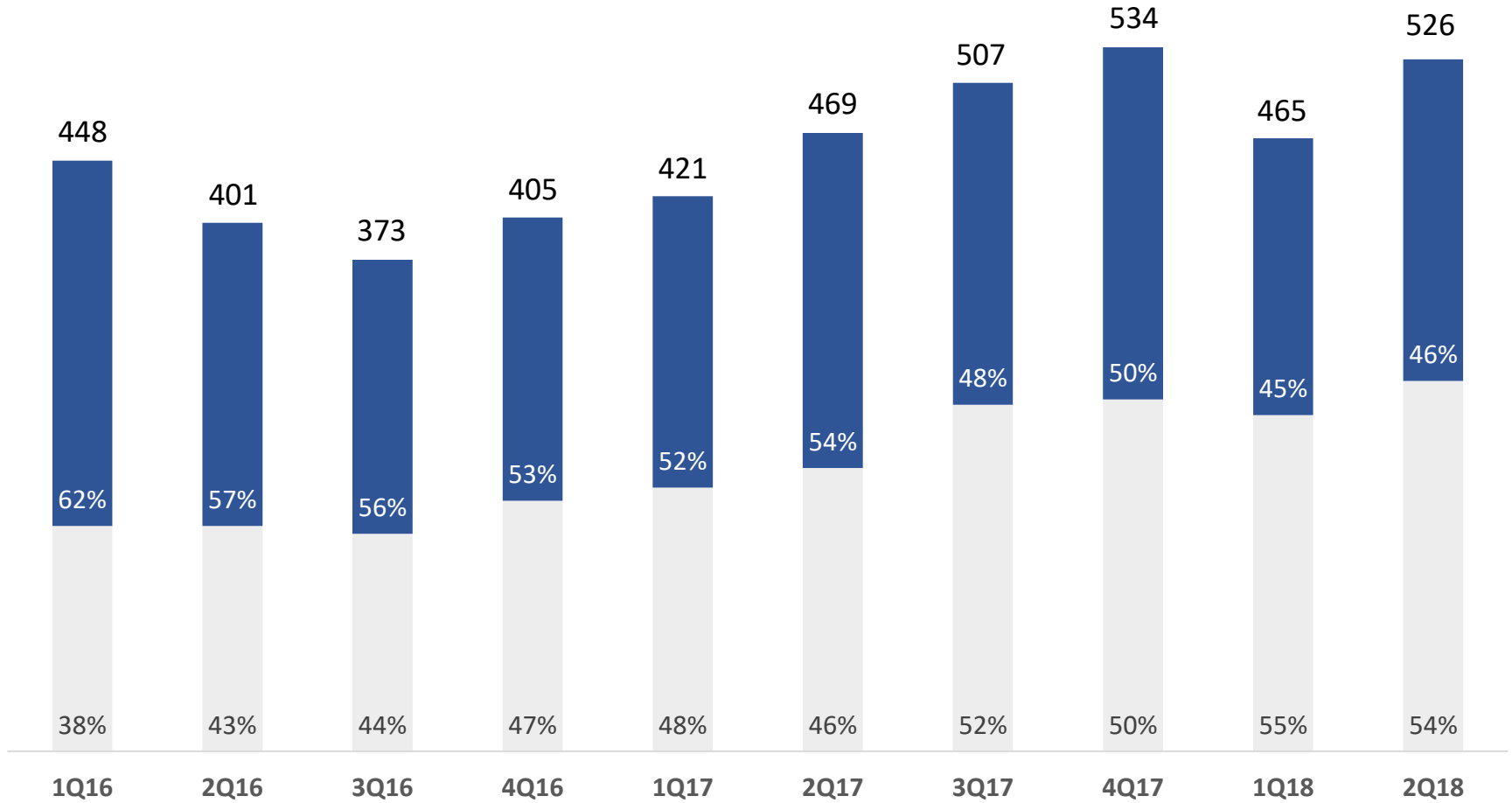
2018년 1H							
구분	2018.2Q	2018.1Q	QOQ	QOQ (%)	2017.2Q	YOY	YOY (%)
매출액 (Sales)	52,575	46,510	+6,065	+13.0%	46,919	+5,656	+12.1%
영업이익 (O.P)	12,748	7,667	+5,081	+66.3%	8,810	+3,938	+44.7%
(%)	24.2%	16.5%	-	-	18.8%	-	-
EBITDA	16,204	17,087	△883	△5.2%	13,744	+2,460	+17.9%
(%)	30.8	36.7%	-	-	29.3%	-	-
당기순이익	15,715	9,962	+5,753	+57.7%	7,481	+8,234	+110.1%
(%)	29.9	21.4%	-	-	15.9%	-	-

\* K-IFRS 적용 기준

# 재무성과

매출액(별도기준) 2분기 YoY +12.1% / QoQ +13.0%

■ 제품 ■ 상품



(단위: 억원)

# 재무성과

영업이익(별도기준) 2분기 영업이익 YoY +44.7% / QoQ +66.3%

